

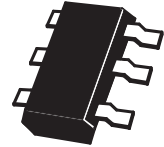
SuperSOT™ 12V PNP SILICON LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR

SUMMARY

$V_{CE0} = -12V$; $R_{SAT} = 65m\Omega$; $I_C = -3A$

DESCRIPTION

This new 4th generation ultra low saturation transistor utilises the Zetex matrix structure combined with advanced assembly techniques to give extremely low on state losses. This makes it ideal for high efficiency, low voltage switching applications.



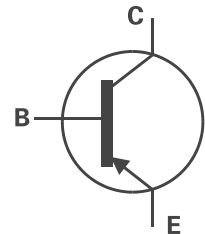
SOT23-6

FEATURES

- Low Equivalent On Resistance
- Extremely Low Saturation Voltage
- h_{FE} characterised up to 10A
- $I_C = 3A$ Continuous Collector Current
- SOT23-6 package

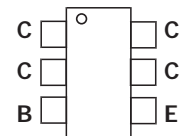
APPLICATIONS

- DC - DC Converters
- Power Management Functions
- Power switches
- Motor control



ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE (inches)	TAPE WIDTH (mm)	QUANTITY PER REEL
ZXT10P12DE6TA	7	8mm embossed	3000 units
ZXT10P12DE6TC	13	8mm embossed	10000 units



Top View

DEVICE MARKING

717

ZXT10P12DE6

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-12	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-12	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-10	A
Continuous Collector Current	I_C	-3	A
Base Current	I_B	-500	mA
Power Dissipation at $T_A=25^{\circ}\text{C}$ (a) Linear Derating Factor	P_D	1.1 8.8	W mW/ $^{\circ}\text{C}$
Power Dissipation at $T_A=25^{\circ}\text{C}$ (b) Linear Derating Factor	P_D	1.7 13.6	W mW/ $^{\circ}\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_J:T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

THERMAL RESISTANCE

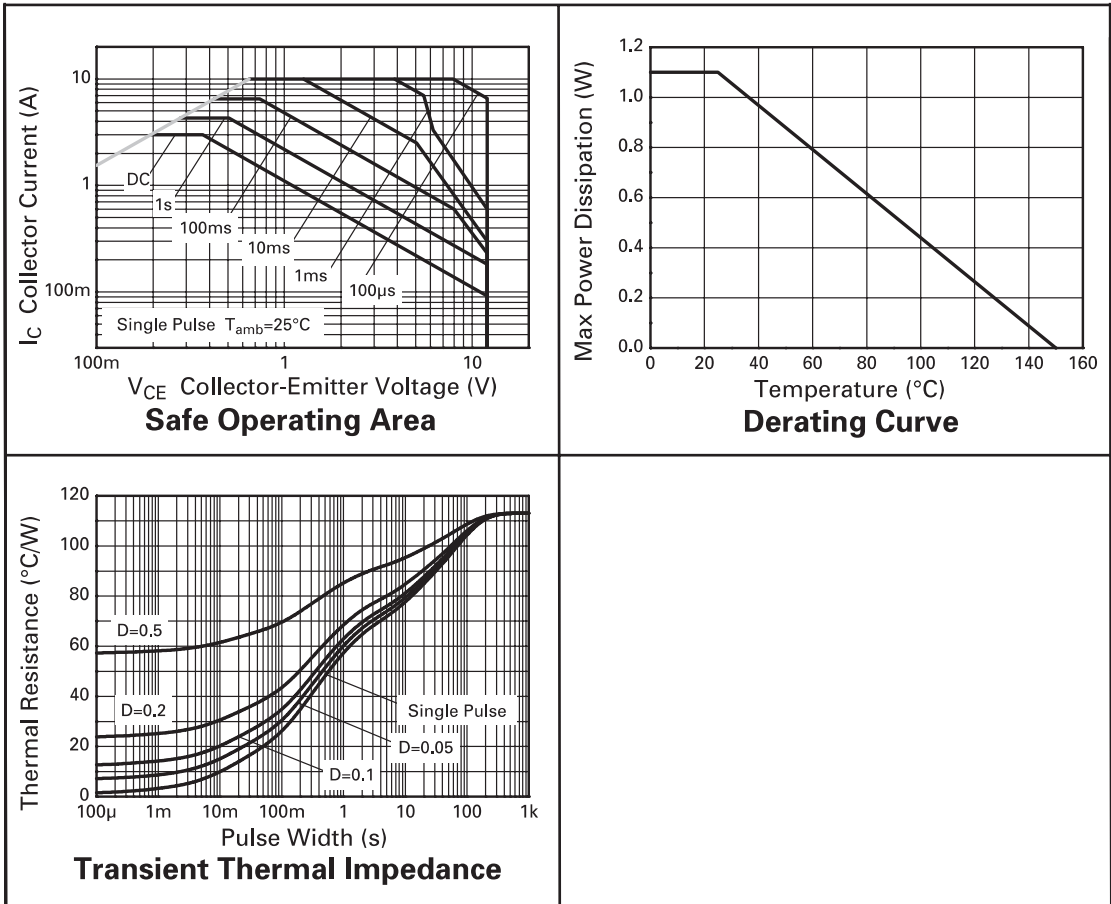
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to Ambient (a)	$R_{\theta JA}$	113	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Ambient (b)	$R_{\theta JA}$	73	$^{\circ}\text{C/W}$

NOTES

(a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions

(b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at $t \leq 5$ secs.

TYPICAL CHARACTERISTICS



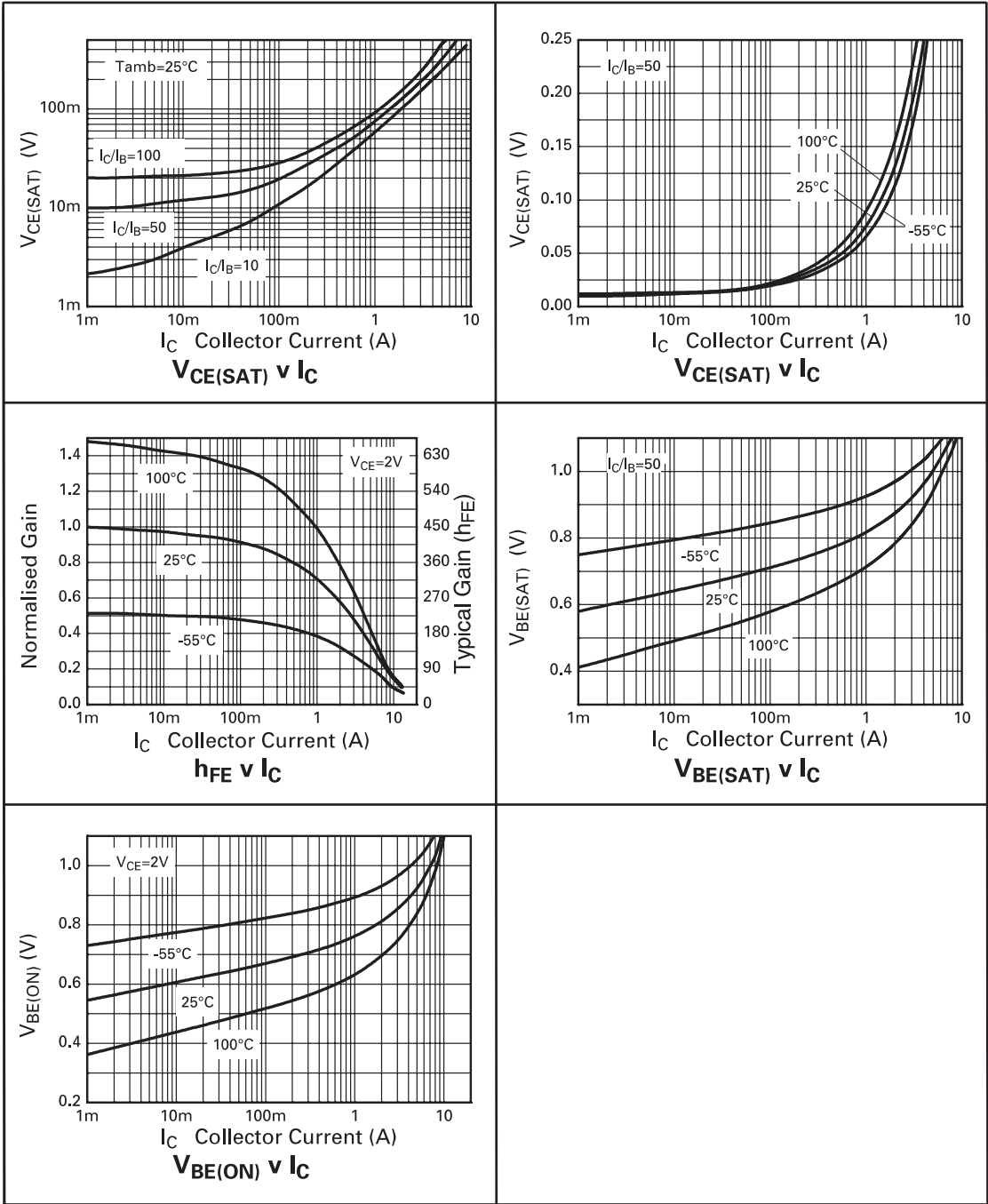
ZXT10P12DE6

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-12	-35		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-12	-25		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5	-8.5		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-100	nA	$V_{CB} = -10\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-100	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}			-100	nA	$V_{CES} = -10\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-10 -100 -100 -195	-17 -140 -150 -300	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1.5\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$ $I_C = -3\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.90	-0.95	V	$I_C = -3\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.85	-0.90	V	$I_C = -3\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 300 180 60 45	475 450 275 100 70			$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -0.1\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -2.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -8\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	80	110		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		21	30	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		70		ns	$V_{CC} = -6\text{V}, I_C = -2\text{A}$ $I_{B1} = I_{B2} = -50\text{mA}$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		130		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

TYPICAL CHARACTERISTICS



ZXT10P12DE6

PACKAGE DIMENSIONS



PAD LAYOUT DETAILS



DIM	Millimetres		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.90	1.45	0.35	0.057
A1	0.00	0.15	0	0.006
A2	0.90	1.30	0.035	0.051
b	0.35	0.50	0.014	0.019
C	0.09	0.20	0.0035	0.008
D	2.80	3.00	0.110	0.118
E	2.60	3.00	0.102	0.118
E1	1.50	1.75	0.059	0.069
L	0.10	0.60	0.004	0.002
e	0.95 REF		0.037 REF	
e1	1.90 REF		0.074 REF	
L	0°	10°	0°	10°



Zetex plc.
Fields New Road, Chadderton, Oldham, OL9-8NP, United Kingdom.
Telephone: (44)161 622 4422 (Sales), (44)161 622 4444 (General Enquiries)
Fax: (44)161 622 4420

Zetex GmbH
Streitfeldstraße 19
D-81673 München
Germany
Telefon: (49) 89 45 49 49 0
Fax: (49) 89 45 49 49 49

Zetex Inc.
47 Mall Drive, Unit 4
Commack NY 11725
USA
Telephone: (631) 543-7100
Fax: (631) 864-7630

Zetex (Asia) Ltd.
3701-04 Metroplaza, Tower 1
Hing Fong Road,
Kwai Fong, Hong Kong
Telephone: (852) 26100 611
Fax: (852) 24250 494

These are supported by
agents and distributors in
major countries world-wide
© Zetex plc 2000

Internet: <http://www.zetex.com>

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



ISSUE 1 - SEPTEMBER 2000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9